

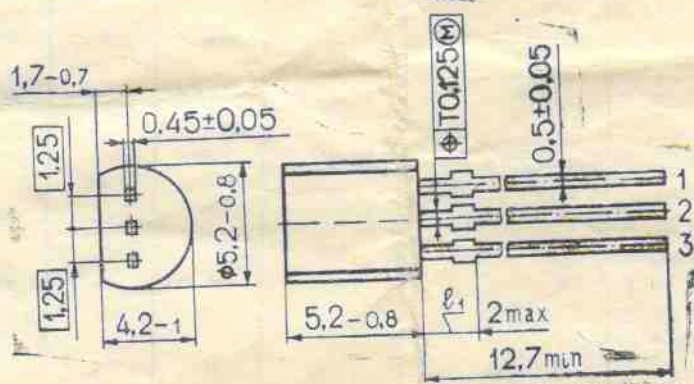


Транзисторы КТ342АМ, КТ342БМ, КТ342ВМ, КТ342ГМ, КТ342ДМ

ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные p-p-p универсальные транзисторы высокой частоты типов: КТ342АМ, КТ342БМ, КТ342ВМ, КТ342ГМ, КТ342ДМ, в пластмассовом корпусе, предназначенные для работы в приемо-усилительной аппаратуре, в цепях вычислительных машин и другой аппаратуре.

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 2.1.



1 — эмиттер, 2 — база, 3 — коллектор.

1. L_1 — неконтролируемая и непригодная для монтажа длина вывода.
2. Позиционный допуск контролируется на расстоянии L_1 max.

Масса — не более 0.3 г

Транзисторы трудногорючие, несамовоспламеняемые.

Тип транзистора обозначается кодом группа — соответствующей буквой, год и месяц изготовления указываются согласно таблицам 1 и 2.

Таблица 1

Год	Код	Год	Код
1986	U	1994	E
1987	V	1995	F
1988	W	1996	H
1989	X	1997	I
1990	A	1998	K
1991	B	1999	L
1992	C	2000	M
1993	D	2001	N

Таблица 2

Месяц	Код	Месяц	Код
Январь	1	Июль	7
Февраль	2	Август	8
Март	3	Сентябрь	9
Апрель	4	Октябрь	0
Май	5	Ноябрь	N
Июнь	6	Декабрь	D

Допускается маркировка транзисторов согласно табл. 3.

Таблица 3

Обозначение типа транзистора		Обозначение группы транзистора	
тип транзистора	цвет маркировочной метки на боковой поверхности корпуса	группа транзистора	цвет маркировочной метки на торце корпуса
КТ342	свиль	АМ	темно-красный
		БМ	желтый
		ВМ	темно-зеленый
		ГМ	голубой
		ДМ	свиль

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t_{amb} = (25 \pm 10)^\circ C$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма		
		КТ342АМ КТ342ГМ	КТ342БМ КТ342ДМ	КТ342ВМ
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_C = 10 \text{ мА}$, $I_B = 1 \text{ мА}$), V , не более	$U_{CE sat}$	0,1	0,1	0,1
Напряжение насыщения база-эмиттер ($I_C = 10 \text{ мА}$, $I_B = 1 \text{ мА}$), V , не более	$U_{BE sat}$	0,9	0,9	0,9
Граничное напряжение ($I_C = 10 \text{ мА}$), V , не менее	$U_{(L)CEO}$	25	20	10
Обратный ток коллектора ($U_{CB} = 25 \text{ В}$), мкА , не более	I_{CBO}	0,05		
($U_{CB} = 20 \text{ В}$), мкА , не более	I_{CBO}		0,05	
($U_{CB} = 10 \text{ В}$), мкА , не более	I_{CBO}			0,05
Обратный ток эмиттера ($U_{EB} = 5 \text{ В}$), мкА , не более	I_{EBO}	30	30	30
Обратный ток коллектор-эмиттер ($R_{BE} = 10 \text{ кОм}$), ($U_{CE} = 30 \text{ В}$), мкА , не более	I_{CER}	30		
($U_{CE} = 25 \text{ В}$), мкА , не более	I_{CER}		30	
($U_{CE} = 10 \text{ В}$), мкА , не более	I_{CER}			30
Статический коэффициент передачи тока ($U_{CB} = 5 \text{ В}$, $I_E = 2 \text{ мА}$), в пределах	h_{21E}	100-250	200-500	400-1000
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{CB} = 10 \text{ В}$, $I_E = 5 \text{ мА}$, $f = 100 \text{ МГц}$), не менее	h_{21e}	2,5 1,5*	3,0 1,5*	3,0
Входное сопротивление в режиме малого сигнала ($U_{CB} = 5 \text{ В}$, $I_E = 1 \text{ мА}$, $f = 1 \cdot 10^{-3} \text{ МГц}$), Ом, не более	h_{11B}	200	200	200
Емкость коллекторного перехода ($U_{CB} = 5 \text{ В}$, $f = 10 \text{ МГц}$), пФ, не более	C_c	8	8	8

* Для группы КТ342ГМ, КТ342ДМ
СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В ОДНОМ ТРАНЗИСТОРЕ:
золото 0,0488 мг палладий 0,0012 мг

Выводы драгоценных металлов не содержат.
СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ В ОДНОМ ТРАНЗИСТОРЕ: в транзисторе цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы КТ342АМ, КТ342БМ, КТ342ВМ, КТ342ГМ, КТ342ДМ соответ- ствуют техническим условиям 3.365.227 ТУ.

ОТК 372